



미국 상무부, 「반도체법」 가드레일 규정 최종 발표

- 우리 기업의 중국 내 설비 유지·부분 확장 및 기술 업그레이드 허용 -
- ①기술 업그레이드 허용, ②업계의견 반영하여 안보 우려 없는 경영활동 보장 -

미국 반도체과학법(이하 반도체법)상 인센티브 수령조건인 중국 내 설비확장 제한기준이 최종 확정되어 안보적 우려가 없는 정상 경영활동은 보장될 것으로 전망된다.

9월 22일(금) 21:45(한국시간) 미 상무부는 반도체법 상 보조금 등 투자 인센티브를 수령하는 기업의 중국 등 우려대상국 내 설비확장 및 기술협력을 제한하는 “가드레일 조항 세부 규정”의 최종안을 공고(3월 초안 발표)하였다.

금번에 발표된 “가드레일 조항 세부 규정”의 주요 내용은 다음과 같다.

① 생산능력 확장 관련, 보조금 수령시점부터 10년간 웨이퍼 기준 5% 이하 확장은 허용. 다만, 일정 사양 이하의 레거시반도체 생산설비 중 △기존 설비는 10% 미만까지 확장이 허용되며, △동 설비에서 생산된 반도체의 85%가 중국 내수용 최종 제품으로 활용될 경우, 확장 규모의 제한은 없음

② 기술협력 관련, 우려대상기관과의 국가안보상 민감 기술·품목에 대한 공동연구·기술 라이센싱을 제한하나, 국가안보 우려가 없는 활동은 예외가 적용되고, 기존 진행중인 연구도 상무부와 협의해서 진행 가능

우리 정부는 ‘22.8월 반도체법 발효 직후부터 “가드레일 조항 세부 규정”을 마련하는 과정에서 미측과 긴밀한 협의를 진행하여 왔다.

그 결과, 당초 세부 규정 초안에서도 우리 기업이 중국에서 운영하고 있는 생산설비의 유지 및 부분적 확장을 보장하였고 기술 업그레이드도 지속 허용할 것으로 판단되었으며, 관련 내용은 최종안에도 포함되었다.

또한, 초안 대비 △생산능력 측정기준(웨이퍼 투입량)을 반도체 시장의 계절별 변동 등을 고려하여 월 단위가 아닌 연 단위로 변경하고, △구축 중인 설비를 상무부 협의시 가드레일 제한의 예외로 인정받을 수 있게 되었으며, △기업이 진행 중인 연구(상무부 협의 필요)나 국제표준을 마련하기 위한 활동 등을 기술협력 제한범위에서 제외하여 업계의 일반적인 경영환경을 반영하고 국가안보 우려가 없는 정상적인 비즈니스 활동은 보장하는 것으로 평가된다. 이외에도 △5% 초과 확장시 투자 금액 제한(기존 10만불 기준)을 기업과의 협약을 통해 정하도록 변경하였다.

동 최종안 공고에 따라 우리 업계는 기업별 글로벌 비즈니스 전략 등을 기반으로 반도체법상 인센티브 규모와 가드레일 조항을 고려하여 대응하겠다는 입장이다. 앞으로 우리 정부는 글로벌 반도체 공급망 강화와 우리 기업의 투자·경영 활동 보장을 위해 美 정부와 협력을 지속할 예정이다.

담당 부서 <총괄>	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	정은지 (044-203-4273)
	통상정책국 미주통상과	책임자	과 장	안홍상 (044-203-5760)
		담당자	사무관	이동욱 (044-203-5658)



< 가드레일 조항 개요 >

- **반도체법상 투자 인센티브 수령기업**(이하 “수혜기업”)은 중국 등 우려대상국*(중국, 북한, 러시아, 이란) 내에서의 설비 확장(확장가드레일) 및 기술협력(기술가드레일)을 제한
 - * 상무부 장관은 국무부·국방부 장관 등과 협의하여 미국의 국가 안보 및 외교 정책에 해로운 행위를 하고 있다고 결정하는 국가를 추가할 수 있음
- 동 의무 위반시 美정부는 해당 기업에 제공한 인센티브 전액을 회수 가능

1. 확장 가드레일(Expansion Guardrail)

- (원칙) 수혜기업은 반도체법상 인센티브 수령조건으로 중국 등 우려 대상국에 있는 생산능력(웨이퍼 기준)을 10년간 5% 이하로 확장 가능
 - 계절별 변동 등 업계의 일반적인 경영환경을 반영하여 생산능력 측정기준을 월 단위에서 연 단위로 변경함으로써 기업 불확실성 해소
 - 5%를 초과하여 생산능력을 확장할 경우 투자금액 제한*이 있으나, 이는 인센티브 신청기업과 美상무부 간 협약 과정**에서 결정
 - * 당초 세부 규정 초안에서는 투자금액 제한 기준을 10만불로 설정
 - ** 인센티브 수혜대상 기업은 美상무부와 인센티브 수령 조건 등에 대한 협약 체결 필요
- (예외①) 일정 사양 이하인 레거시반도체(legacy semiconductor) 제조 설비 중 기존에 있는 설비·장비*는 10% 미만까지 확장이 가능

< 레거시 반도체 기준 >

- ① 디지털, 아날로그 로직 반도체 : 28nm 및 이전세대
 - ② 메모리 반도체 : DRAM은 18nm 초과, NAND 플래시는 128단 미만(특성 신기술 미활용)
 - ③ 상무장관이 공지를 통해 정하는 기술
- * 단, ① 국가안보에 중요한 반도체 ② FinFET, GAAFET 등의 구조의 반도체, ③ 3D적층 패키징을 활용한 반도체는 레거시 반도체에 해당되지 않음

- 기존 시설이란 인센티브 수령 이전에 건설·구축되어 운영중인 시설로, 美상무부 장관의 재량에 따라 수령 시점에 구축 중인 시설도 포함 가능

- (예외②) 레거시반도체 제조 설비 중 생산된 반도체의 85%가 중국 등 우려대상국 시장에서 소비되는 최종제품에 활용시 확장 규모의 제한은 無
- (주요 고려사항) 확장 규모 제한범위 내에서의 기술 업그레이드 및 기존 설비 유지를 위한 장비 교체 허용(단, 대중 수출통제는 준수 필요)

2. 기술 가드레일(Technology Guardrail)

- (원칙) 우려대상기업*과 국가안보 우려를 높일 수 있는 기술·품목**에 대해 공동 연구 및 기술 라이센싱에 참여 제한
 - * 미국 정부의 제재 명단에 포함된 기업, 중국 등 우려대상국 정부가 소유·통제하는 기업 등
 - ** △국가안보에 중요한 반도체 및 △美상무부 수출통제리스트(CCL) 중 카테고리3(전자)
- (예외) △기준에 진행 중인 연구, △국가안보 우려를 높이지 않는 기술·품목(예 : 국제표준 활동, 특허 관련 활동, 품질보증 등)은 가능

< (참고) 반도체법 주요 경과 >

- ① 반도체법 발효('22.8월)
- ② 보조금 지원기준 및 절차 발표(NOFO, Notice of Funding Opportunities)
 - ① 반도체 제조설비('23.2.28일)
 - ② 대규모(3억불 이상) 소재·장비 제조시설 및 웨이퍼 제조시설 투자('23.6.23일)
 - ③ 소규모(3억불 미만) 소재·장비 제조시설 및 웨이퍼 제조시설 투자(추후 발표 예정)
 - ④ R&D 시설 투자(추후 발표예정)
- ③ 가드레일 조항 세부 규정
 - ① 초안 발표('23.3.21일), 의견수렴(~'23.5.22일)
 - ② 최종안 발표('23.9.22일)